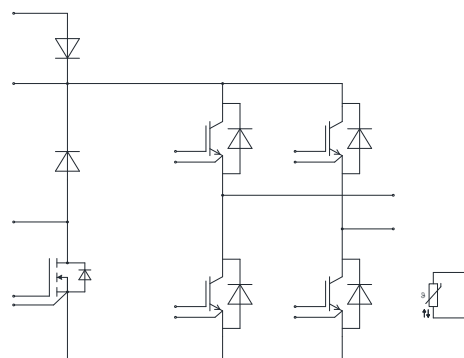
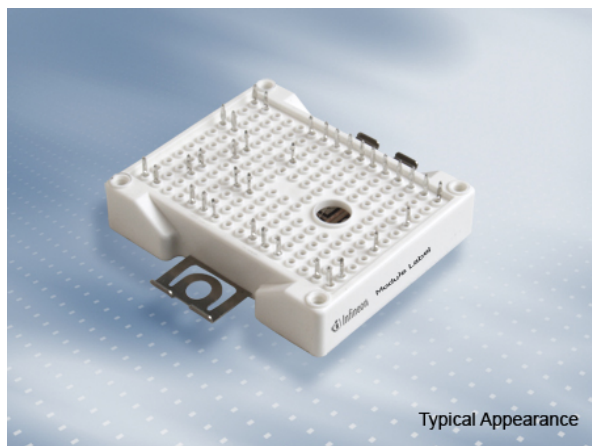


EasyBRIDGE モジュール CoolMOS内蔵 and PressFIT / NTCサーミスタ  
EasyBRIDGE module with CoolMOS and PressFIT / NTC

## 暫定データ / Preliminary Data



$V_{CES} = 650V$

$I_{C\ nom} = 75A / I_{CRM} = 150A$

## 一般応用

- ソーラーアプリケーション

## Typical Applications

- Solar Applications

## 電気的特性

- 650Vに増加したブロッキング電圧
- 低  $V_{CESat}$  飽和電圧

## Electrical Features

- Increased blocking voltage capability to 650V
- Low  $V_{CESat}$

## 機械的特性

- 低熱インピーダンスの  $Al_2O_3$  DCB
- 内蔵されたNTCサーミスタ
- PressFIT 接合 技術

## Mechanical Features

- $Al_2O_3$  Substrate with Low Thermal Resistance
- Integrated NTC temperature sensor
- PressFIT Contact Technology

## Module Label Code

Barcode Code 128



DMX - Code



## Content of the Code

Content of the Code	Digit
Module Serial Number	1 - 5
Module Material Number	6 - 11
Production Order Number	12 - 19
Datecode (Production Year)	20 - 21
Datecode (Production Week)	22 - 23

prepared by: MB

date of publication: 2014-10-15

approved by: AKDA

revision: 2.0

UL approved (E83335)

暫定データ  
Preliminary Data

IGBT- インバータ / IGBT, Inverter

最大定格 / Maximum Rated Values

コレクタ・エミッタ間電圧 Collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{CES}$	650	V
コレクタ電流 Implemented collector current		$I_{CN}$	75	A
連続DCコレクタ電流 Continuous DC collector current	$T_C = 100^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175^{\circ}\text{C}$ $T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175^{\circ}\text{C}$	$I_{C\text{ nom}}$ $I_C$	37,5 75	A A
繰り返しピークコレクタ電流 Repetitive peak collector current	$t_P = 1\text{ ms}$	$I_{CRM}$	150	A
トータル損失 Total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175^{\circ}\text{C}$	$P_{\text{tot}}$	250	W
ゲート・エミッタ間ピーク電圧 Gate-emitter peak voltage		$V_{GES}$	+/-20	V

電気的特性 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧 Collector-emitter saturation voltage	$I_C = 37,5\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$ $I_C = 37,5\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$ $I_C = 37,5\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_{CE\text{ sat}}$		1,35 1,40 1,40	1,55 V V V
ゲート・エミッタ間しきい値電圧 Gate threshold voltage	$I_C = 1,20\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$V_{G\text{ETH}}$	4,90	5,80	6,50 V
ゲート電荷量 Gate charge	$V_{GE} = -15\text{ V} \dots +15\text{ V}$		$Q_G$		0,80	$\mu\text{C}$
内蔵ゲート抵抗 Internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$R_{G\text{int}}$		0,0	$\Omega$
入力容量 Input capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		$C_{\text{ies}}$		4,70	nF
帰還容量 Reverse transfer capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		$C_{\text{res}}$		0,14	nF
コレクタ・エミッタ間遮断電流 Collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 650\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$I_{CES}$			1,0 mA
ゲート・エミッタ間漏れ電流 Gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		$I_{GES}$			100 nA
ターンオン遅れ時間 (誘導負荷) Turn-on delay time, inductive load	$I_C = 37,5\text{ A}, V_{CE} = 400\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{G\text{on}} = 8,2\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_{d\text{ on}}$		0,027 0,027 0,027	$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
ターンオン上昇時間 (誘導負荷) Rise time, inductive load	$I_C = 37,5\text{ A}, V_{CE} = 400\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{G\text{on}} = 8,2\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_r$		0,016 0,017 0,018	$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
ターンオフ遅れ時間 (誘導負荷) Turn-off delay time, inductive load	$I_C = 37,5\text{ A}, V_{CE} = 400\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{G\text{off}} = 8,2\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_{d\text{ off}}$		0,23 0,27 0,28	$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
ターンオフ下降時間 (誘導負荷) Fall time, inductive load	$I_C = 37,5\text{ A}, V_{CE} = 400\text{ V}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ $R_{G\text{off}} = 8,2\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_f$		0,01 0,02 0,02	$\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$ $\mu\text{s}$
ターンオンスイッチング損失 Turn-on energy loss per pulse	$I_C = 37,5\text{ A}, V_{CE} = 400\text{ V}, L_S = 20\text{ nH}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, di/dt = 1900\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $R_{G\text{on}} = 8,2\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$E_{\text{on}}$		1,10 1,45 1,50	mJ mJ mJ
ターンオフスイッチング損失 Turn-off energy loss per pulse	$I_C = 37,5\text{ A}, V_{CE} = 400\text{ V}, L_S = 20\text{ nH}$ $V_{GE} = \pm 15\text{ V}, du/dt = 4000\text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $R_{G\text{off}} = 8,2\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$E_{\text{off}}$		0,65 1,05 1,15	mJ mJ mJ
短絡電流 SC data	$V_{GE} \leq 15\text{ V}, V_{CC} = 400\text{ V}$ $V_{CE\text{ max}} = V_{CES} - L_{S\text{CE}} \cdot di/dt$ $t_P \leq 5\ \mu\text{s}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		$I_{SC}$		430	A
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case	IGBT部 ( 1 素子当り ) / per IGBT		$R_{th\text{JC}}$		0,55 0,60	K/W

prepared by: MB	date of publication: 2014-10-15
approved by: AKDA	revision: 2.0

暫定データ  
Preliminary Data

ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	IGBT部 ( 1 素子当り ) / per IGBT $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$	$R_{\text{thCH}}$		0,75		K/W
動作温度 Temperature under switching conditions		$T_{\text{vj op}}$	-40		150	°C

Diode、インバータ / Diode, Inverter

最大定格 / Maximum Rated Values

ピーク繰返し逆電圧 Repetitive peak reverse voltage	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$	$V_{\text{RRM}}$	650	V
順電流 Implemented forward current		$I_{\text{FN}}$	50	A
連続DC電流 Continuous DC forward current		$I_{\text{F}}$	37,5	A
ピーク繰返し順電流 Repetitive peak forward current	$t_{\text{p}} = 1 \text{ ms}$	$I_{\text{FRM}}$	100	A
電流二乗時間積 $I^2t$ - value	$V_{\text{R}} = 0 \text{ V}, t_{\text{p}} = 10 \text{ ms}, T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}$ $V_{\text{R}} = 0 \text{ V}, t_{\text{p}} = 10 \text{ ms}, T_{\text{vj}} = 150^\circ\text{C}$	$I^2t$	370 330	$\text{A}^2\text{s}$ $\text{A}^2\text{s}$

電気的特性 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
順電圧 Forward voltage	$I_{\text{F}} = 37,5 \text{ A}, V_{\text{GE}} = 0 \text{ V}$ $I_{\text{F}} = 37,5 \text{ A}, V_{\text{GE}} = 0 \text{ V}$ $I_{\text{F}} = 37,5 \text{ A}, V_{\text{GE}} = 0 \text{ V}$	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 150^\circ\text{C}$	$V_{\text{F}}$	1,45 1,35 1,30	1,70	V V V
ピーク逆回復電流 Peak reverse recovery current	$I_{\text{F}} = 37,5 \text{ A}, -di_{\text{F}}/dt = 1900 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{\text{vj}}=150^\circ\text{C})$ $V_{\text{R}} = 400 \text{ V}$ $V_{\text{GE}} = -15 \text{ V}$	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 150^\circ\text{C}$	$I_{\text{RM}}$	49,0 59,0 63,0		A A A
逆回復電荷量 Recovered charge	$I_{\text{F}} = 37,5 \text{ A}, -di_{\text{F}}/dt = 1900 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{\text{vj}}=150^\circ\text{C})$ $V_{\text{R}} = 400 \text{ V}$ $V_{\text{GE}} = -15 \text{ V}$	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 150^\circ\text{C}$	$Q_{\text{r}}$	1,90 3,60 4,00		$\mu\text{C}$ $\mu\text{C}$ $\mu\text{C}$
逆回復損失 Reverse recovery energy	$I_{\text{F}} = 37,5 \text{ A}, -di_{\text{F}}/dt = 1900 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{\text{vj}}=150^\circ\text{C})$ $V_{\text{R}} = 400 \text{ V}$ $V_{\text{GE}} = -15 \text{ V}$	$T_{\text{vj}} = 25^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 125^\circ\text{C}$ $T_{\text{vj}} = 150^\circ\text{C}$	$E_{\text{rec}}$	0,50 1,00 1,20		mJ mJ mJ
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case	/Diode ( 1 素子当り ) / per diode		$R_{\text{thJC}}$	1,00	1,10	K/W
ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	/Diode ( 1 素子当り ) / per diode $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$		$R_{\text{thCH}}$	1,25		K/W
動作温度 Temperature under switching conditions			$T_{\text{vj op}}$	-40	150	°C

prepared by: MB	date of publication: 2014-10-15
approved by: AKDA	revision: 2.0

暫定データ  
Preliminary Data

バイパスダイオード / Bypass-Diode

最大定格 / Maximum Rated Values

ピーク繰返し逆電圧 Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{RRM}$	800	V
最大実効順電流/chip Maximum RMS forward current per chip	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	$I_{FRMSM}$	50	A
整流出力の最大実効電流 Maximum RMS current at rectifier output	$T_C = 80^{\circ}\text{C}$	$I_{RMSM}$	75	A
サージ順電流 Surge forward current	$t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$I_{FSM}$	800 640	A A
電流二乗時間積 $I^2t$ - value	$t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$I^2t$	3200 2050	A <sup>2</sup> s A <sup>2</sup> s

電気的特性 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
順電圧 Forward voltage	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}, I_F = 50\text{ A}$	$V_F$		0,90		V
逆電流 Reverse current	$T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}, V_R = 800\text{ V}$	$I_R$		0,20		mA
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case	/Diode ( 1 素子当り ) / per diode	$R_{thJC}$		0,45	0,55	K/W
ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	/Diode ( 1 素子当り ) / per diode $\lambda_{\text{Paste}} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	$R_{thCH}$		0,45		K/W
動作温度 Temperature under switching conditions		$T_{vj\text{ op}}$	-40		150	$^{\circ}\text{C}$

Diode, アップコンバータ / Diode, Boost

最大定格 / Maximum Rated Values

ピーク繰返し逆電圧 Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{RRM}$	650	V
連続DC電流 Continuous DC forward current		$I_F$	24	A
ピーク繰返し順電流 Repetitive peak forward current	$t_p = 1\text{ ms}$	$I_{FRM}$	48	A
電流二乗時間積 $I^2t$ - value	$V_R = 0\text{ V}, t_p = 10\text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$I^2t$	72,0	A <sup>2</sup> s

電気的特性 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
順電圧 Forward voltage	$I_F = 24\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 24\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$V_F$	1,50 1,65	1,85	V V
ピーク逆回復電流 Peak reverse recovery current	$I_F = 24\text{ A}, -di_F/dt = 1500\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=125^{\circ}\text{C})$ $V_R = 400\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$I_{RM}$	12,5 12,5		A A
逆回復電荷量 Recovered charge	$I_F = 24\text{ A}, -di_F/dt = 1500\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=125^{\circ}\text{C})$ $V_R = 400\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$Q_r$	0,30 0,30		$\mu\text{C}$ $\mu\text{C}$
逆回復損失 Reverse recovery energy	$I_F = 24\text{ A}, -di_F/dt = 1500\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj}=125^{\circ}\text{C})$ $V_R = 400\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$	$E_{rec}$	0,03 0,03		mJ mJ
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case	/Diode ( 1 素子当り ) / per diode	$R_{thJC}$		0,90	1,00	K/W
ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	/Diode ( 1 素子当り ) / per diode $\lambda_{\text{Paste}} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$	$R_{thCH}$		0,95		K/W
動作温度 Temperature under switching conditions		$T_{vj\text{ op}}$	-40		125	$^{\circ}\text{C}$

prepared by: MB	date of publication: 2014-10-15
approved by: AKDA	revision: 2.0

暫定データ  
Preliminary Data

MOSFET / MOSFET

最大定格 / Maximum Rated Values

ドレイン・ソース間ブレークダウン電圧 Drain-source breakdown voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{DSS}$	650	V
DCドレイン電流 DC drain current	$T_C = 100^{\circ}\text{C}$ $T_C = 25^{\circ}\text{C}$	$I_{D\text{ nom}}$ $I_D$	30 50	A A
パルスドレイン電流 (tpはTjmaxにより制限される) Pulsed drain current, tp limited by Tjmax		$I_{D\text{ puls}}$	100	A
許容損失 Total power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	$P_{\text{tot}}$	520	W
ゲート・ソース間ピーク電圧 Gate-source peak voltage		$V_{GSS}$	+/-20	V

電気的特性 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
ドレイン・ソース間オン抵抗 Drain-source on resistance	$I_D = 30\text{ A}, V_{GS} = 10\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$R_{DS\text{ on}}$		38,0	42,0	mΩ
ゲートしきい値電圧 Gate threshold voltage	$I_D = 3,30\text{ mA}, V_{DS} = V_{GS}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{GS(th)}$	2,50	3,00	3,50	V
ゲート入力電荷量 Gate charge	$V_{GS} = 10\text{ V}, V_{DD} = 480\text{ V}$	$Q_G$		0,33		μC
内蔵ゲート抵抗 Internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$R_{Gint}$		0,7		Ω
入力容量 Input capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{DS} = 25\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}$	$C_{iss}$		8,00		nF
出力容量 Output capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{DS} = 25\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}$	$C_{oss}$		7,50		nF
帰還容量 Reverse transfer capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{DS} = 25\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}$	$C_{rss}$		0,80		nF
Vg=0V時、ドレイン電流 Zero gate voltage drain current	$V_{DS} = 650\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$I_{DSS}$			2,00	μA
ゲート・ソース間漏れ電流 Gate-source leakage current	$V_{DS} = 0\text{ V}, V_{GS} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$I_{GSS}$			100	nA
ターンオン遅延時間 (誘導負荷) Turn on delay time, inductive load	$I_D = 30\text{ A}, V_{DS} = 400\text{ V}$ $V_{GS} = 10\text{ V}$ $R_G = 7,50\text{ Ω}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_{d\text{ on}}$	20,0 17,5 16,0		ns
ターンオン上昇時間 (誘導負荷) Rise time, inductive load	$I_D = 30\text{ A}, V_{DS} = 400\text{ V}$ $V_{GS} = 10\text{ V}$ $R_G = 7,50\text{ Ω}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_r$	15,0 15,5 16,0		ns
ターンオフ遅延時間 (誘導負荷) Turn off delay time, inductive load	$I_D = 30\text{ A}, V_{DS} = 400\text{ V}$ $V_{GS} = 10\text{ V}$ $R_G = 7,50\text{ Ω}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_{d\text{ off}}$	210 220 220		ns
ターンオフ下降時間 (誘導負荷) Fall time, inductive load	$I_D = 30\text{ A}, V_{DS} = 400\text{ V}$ $V_{GS} = 10\text{ V}$ $R_G = 7,50\text{ Ω}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_f$	7,50 9,00 9,00		ns
ターンオンスイッチング損失/パルス Turn-on energy loss per pulse	$I_D = 30\text{ A}, V_{DS} = 400\text{ V}, L_{\sigma} = 25\text{ nH}$ $V_{GS} = 10\text{ V}, di/dt = 1600\text{ A/μs} (T_{vj} = 150)$ $R_G = 7,50\text{ Ω}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$E_{on}$	0,32 0,36 0,37		mJ
ターンオフスイッチング損失/パルス Turn-off energy loss per pulse	$I_D = 30\text{ A}, V_{DS} = 400\text{ V}, L_{\sigma} = 25\text{ nH}$ $V_{GS} = 10\text{ V}, du/dt = 19500\text{ V/μs} (T_{vj} = 150)$ $R_G = 7,50\text{ Ω}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$E_{off}$	0,08 0,09 0,095		mJ
ジャンクション・ケース間熱抵抗 Thermal resistance, junction to case		$R_{thJC}$		0,35	0,40	K/W
ケース・ヒートシンク間熱抵抗 Thermal resistance, case to heatsink	pro MOS-FET / per MOS-FET $\lambda_{\text{Paste}} = 1\text{ W/(m}^2\text{K)} / \lambda_{\text{grease}} = 1\text{ W/(m}^2\text{K)}$	$R_{thCH}$		0,40		K/W
動作温度 Temperature under switching conditions		$T_{vj\text{ op}}$	-40		150	°C

Revers-Diode / reverse-diode

			min.	typ.	max.	
順電圧 Forward voltage	$I_S = 50\text{ A}, V_{GS} = 0\text{ V}$ $I_S = 50\text{ A}, V_{GS} = 0\text{ V}$ $I_S = 50\text{ A}, V_{GS} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_{SD}$	0,85 0,70	1,30	V

prepared by: MB	date of publication: 2014-10-15
approved by: AKDA	revision: 2.0

暫定データ  
Preliminary Data

NTC-サーミスタ / NTC-Thermistor

電気的特性 / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
定格抵抗値 Rated resistance	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	$R_{25}$		5,00		k $\Omega$
R100の偏差 Deviation of R100	$T_C = 100^{\circ}\text{C}$ , $R_{100} = 493 \Omega$	$\Delta R/R$	-5		5	%
損失 Power dissipation	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$	$P_{25}$			20,0	mW
B-定数 B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$	$B_{25/50}$		3375		K
B-定数 B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$	$B_{25/80}$		3411		K
B-定数 B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$	$B_{25/100}$		3433		K

適切なアプリケーションノートによる仕様  
Specification according to the valid application note.

モジュール / Module

絶縁耐圧 Isolation test voltage	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$ , $t = 1 \text{ min.}$	$V_{\text{ISOL}}$		2,5		kV
内部絶縁 Internal isolation	基礎絶縁 (クラス1, IEC 61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)			$\text{Al}_2\text{O}_3$		
沿面距離 Creepage distance	連絡方法 - ヒートシンク / terminal to heatsink 連絡方法 - 連絡方法 / terminal to terminal			11,5 6,3		mm
空間距離 Clearance	連絡方法 - ヒートシンク / terminal to heatsink 連絡方法 - 連絡方法 / terminal to terminal			10,0 5,0		mm
相対トラッキング指数 Comperative tracking index		CTI		> 200		
内部インダクタンス Stray inductance module		$L_{\text{sCE}}$		17		nH
パワーターミナル・チップ間抵抗 Module lead resistance, terminals - chip	$T_C = 25^{\circ}\text{C}$ , /スイッチ / per switch	$R_{\text{CC}'+\text{EE}'}$		3,00		m $\Omega$
保存温度 Storage temperature		$T_{\text{stg}}$	-40		125	$^{\circ}\text{C}$
Anpresskraft für mech. Bef. pro Feder mounting force per clamp		F	40	-	80	N
質量 Weight		G		39		g

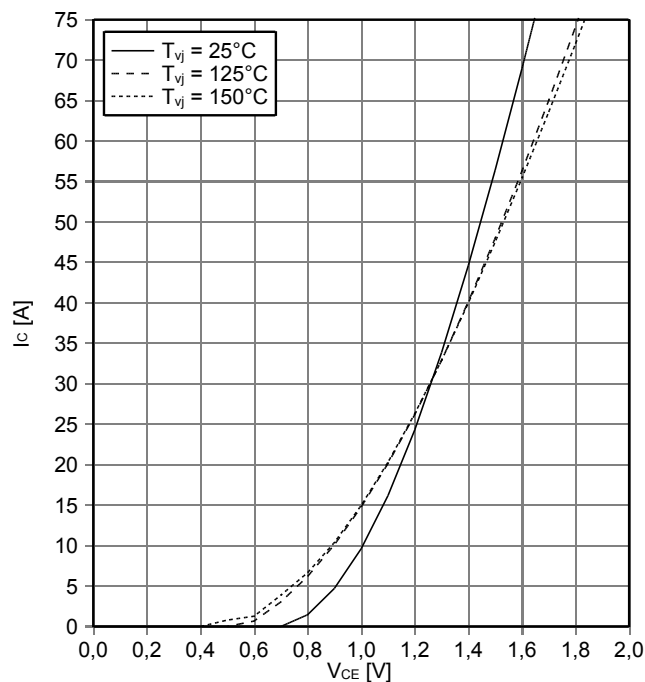
Der Strom im Dauerbetrieb ist auf 25 A effektiv pro Anschlusspin begrenzt.  
The current under continuous operation is limited to 25 A rms per connector pin.

prepared by: MB	date of publication: 2014-10-15
approved by: AKDA	revision: 2.0

暫定データ  
Preliminary Data

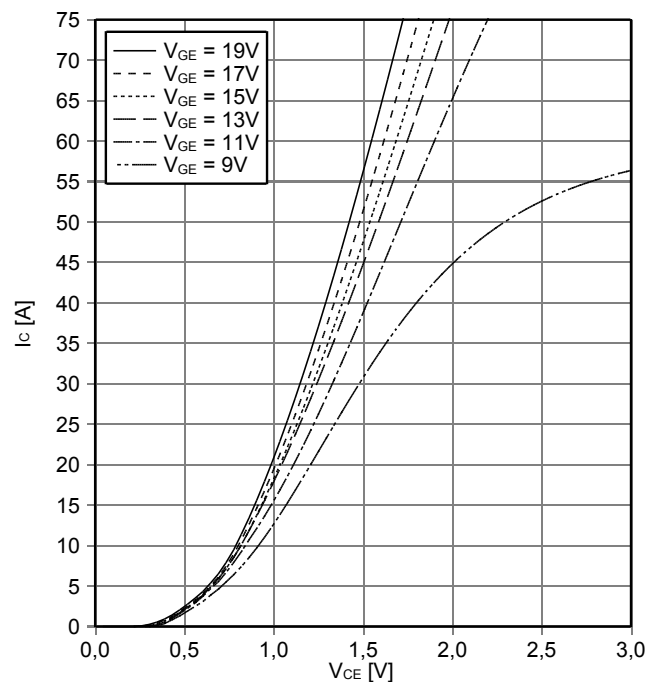
出力特性 IGBT- インバータ (Typical)  
output characteristic IGBT, Inverter (typical)

$I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = 15\text{ V}$



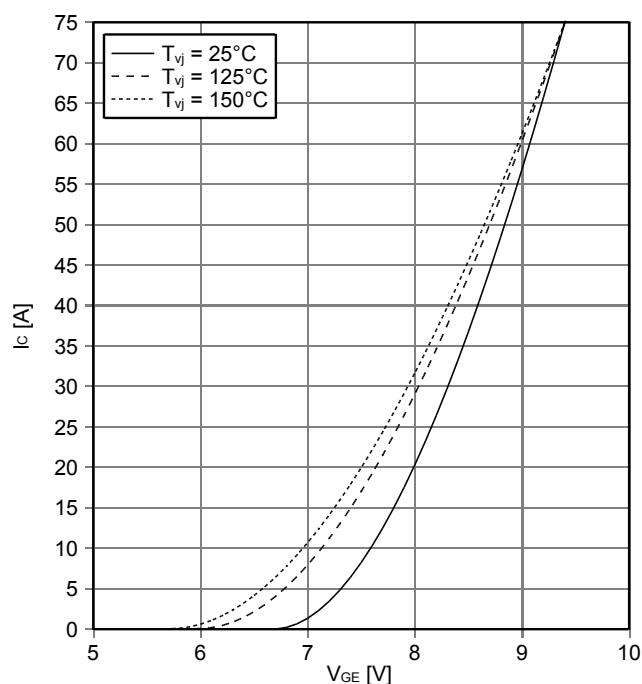
出力特性 IGBT- インバータ (Typical)  
output characteristic IGBT, Inverter (typical)

$I_C = f(V_{CE})$   
 $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



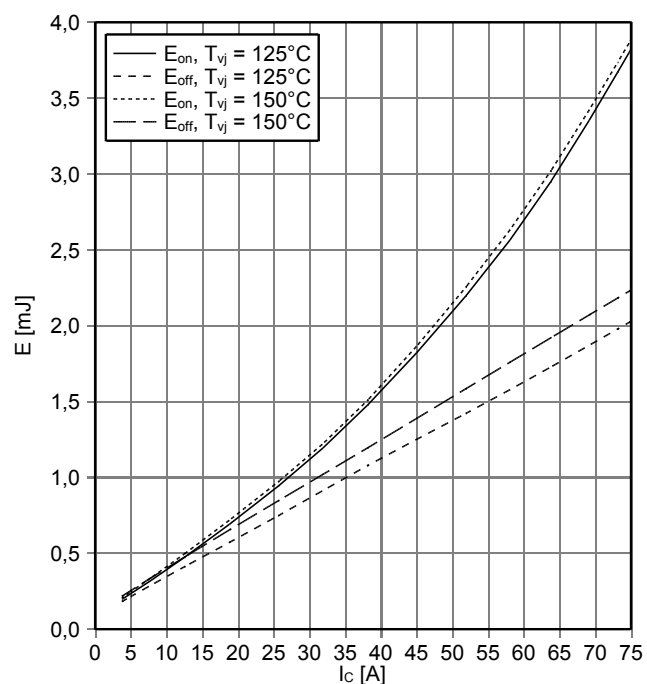
伝達特性 IGBT- インバータ (Typical)  
transfer characteristic IGBT, Inverter (typical)

$I_C = f(V_{GE})$   
 $V_{CE} = 20\text{ V}$



スイッチング損失 IGBT- インバータ (Typical)  
switching losses IGBT, Inverter (typical)

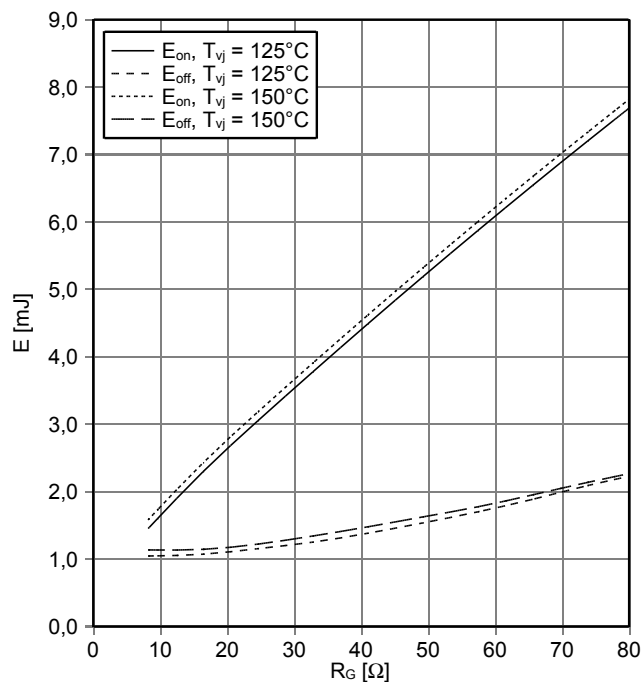
$E_{on} = f(I_C)$ ,  $E_{off} = f(I_C)$   
 $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$ ,  $R_{Gon} = 8.2\ \Omega$ ,  $R_{Goff} = 8.2\ \Omega$ ,  $V_{CE} = 400\text{ V}$



暫定データ  
Preliminary Data

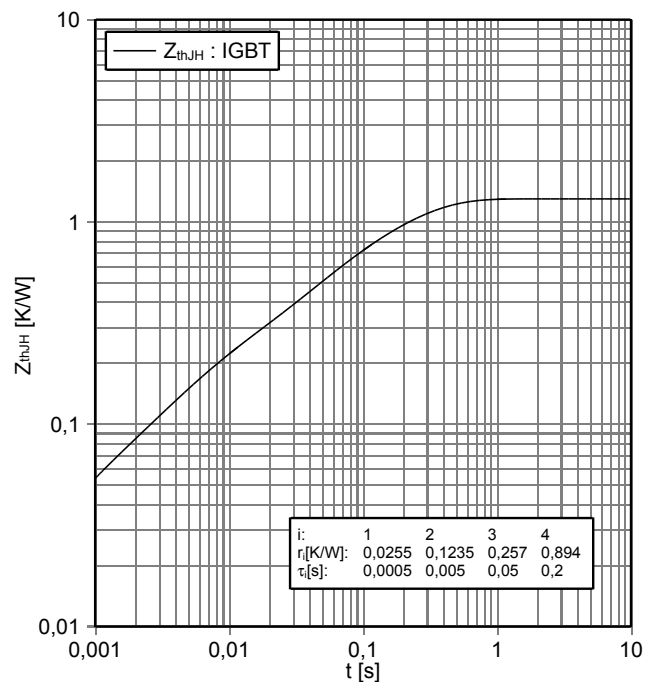
スイッチング損失 IGBT- インバータ (Typical)  
switching losses IGBT, Inverter (typical)

$E_{on} = f(R_G)$ ,  $E_{off} = f(R_G)$   
 $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ ,  $I_C = 37.5 \text{ A}$ ,  $V_{CE} = 400 \text{ V}$



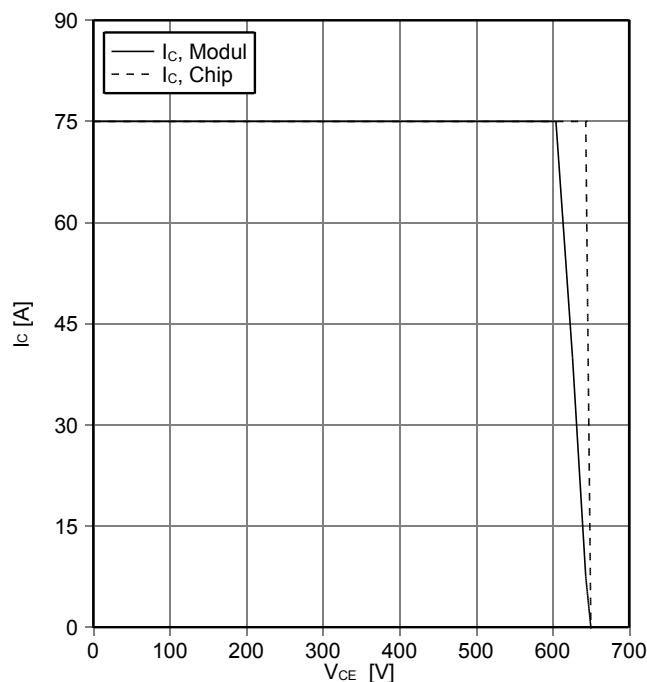
過渡熱インピーダンス IGBT- インバータ  
transient thermal impedance IGBT, Inverter

$Z_{thJH} = f(t)$



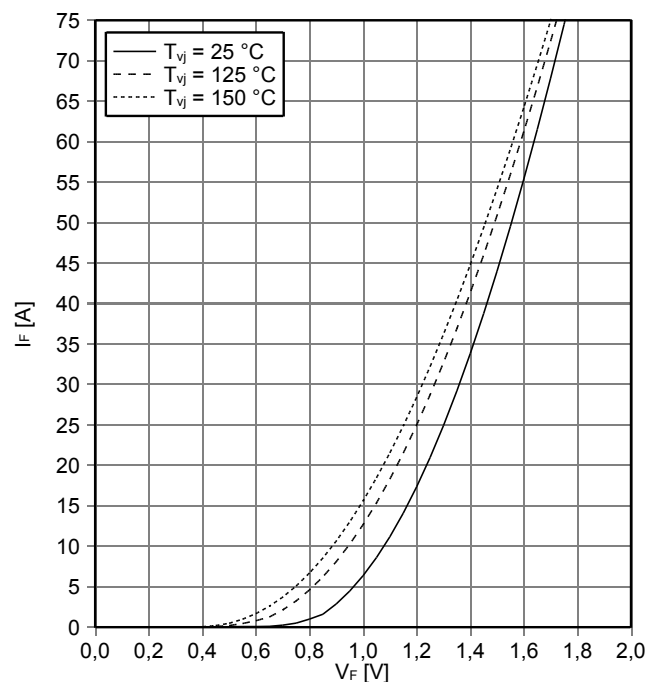
逆バイアス安全動作領域 IGBT- インバータ (RBSOA)  
reverse bias safe operating area IGBT, Inverter (RBSOA)

$I_C = f(V_{CE})$   
 $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$ ,  $R_{Goff} = 8.2 \Omega$ ,  $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



順電圧特性 Diode、インバータ (typical)  
forward characteristic of Diode, Inverter (typical)

$I_F = f(V_F)$

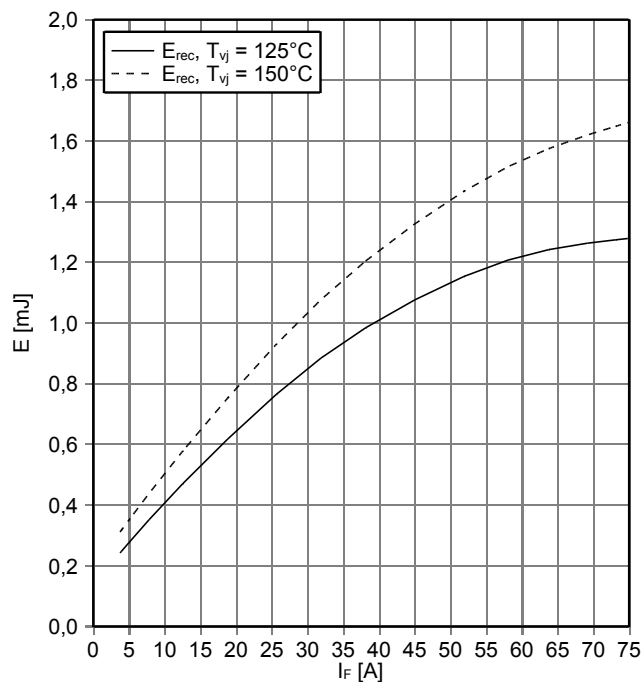




暫定データ  
Preliminary Data

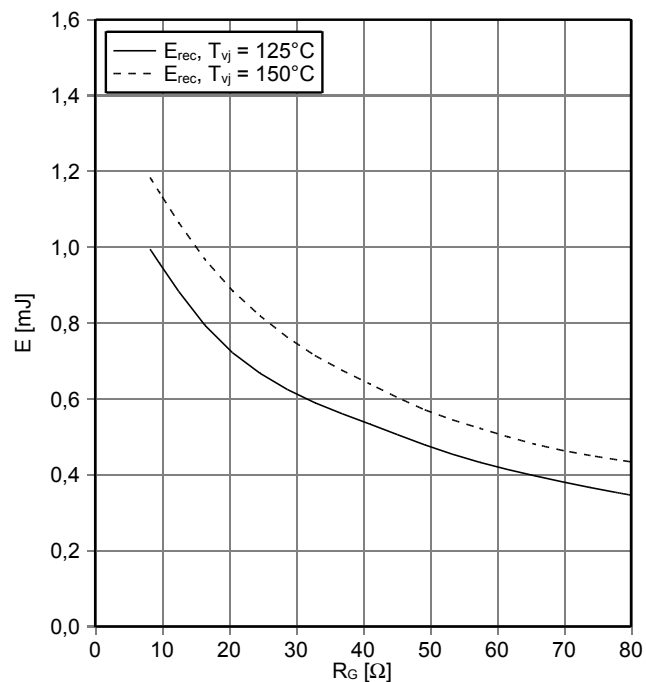
スイッチング損失 Diode、インバータ (Typical)  
switching losses Diode, Inverter (typical)

$E_{rec} = f(I_F)$   
 $R_{Gon} = 8.2 \Omega$ ,  $V_{CE} = 400 V$



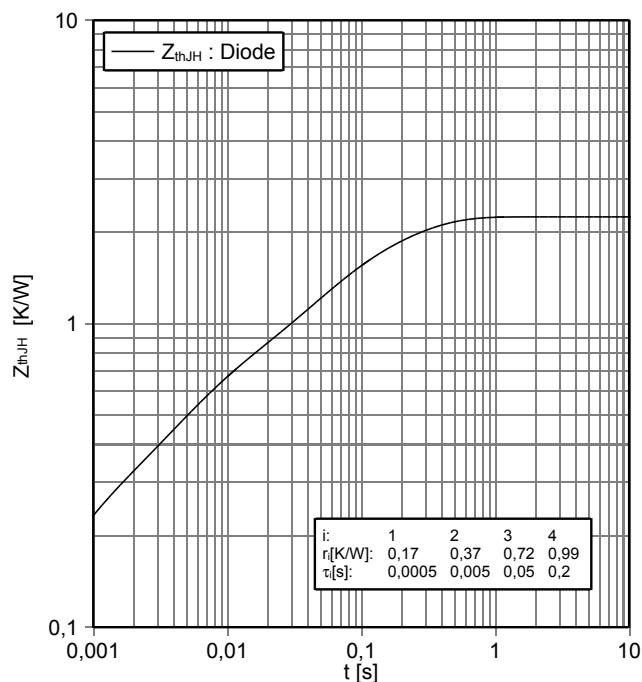
スイッチング損失 Diode、インバータ (Typical)  
switching losses Diode, Inverter (typical)

$E_{rec} = f(R_G)$   
 $I_F = 37.5 A$ ,  $V_{CE} = 400 V$



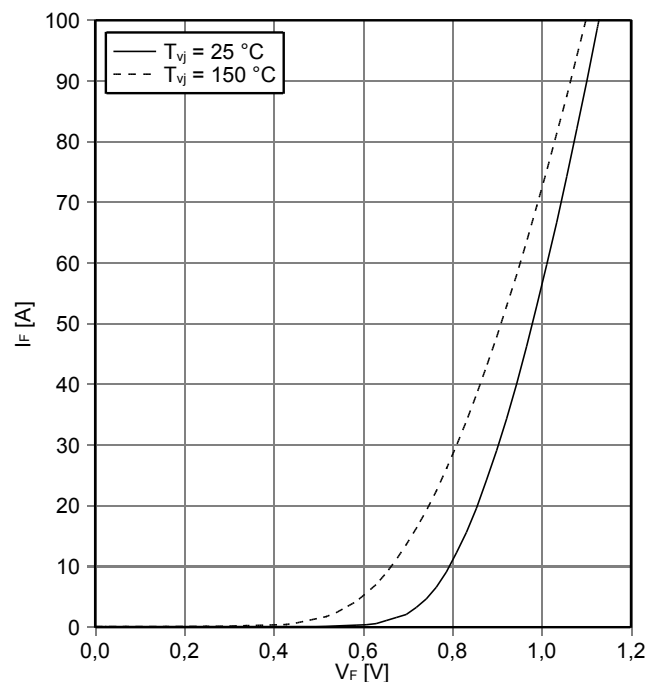
過渡熱インピーダンス Diode、インバータ  
transient thermal impedance Diode, Inverter

$Z_{thJH} = f(t)$



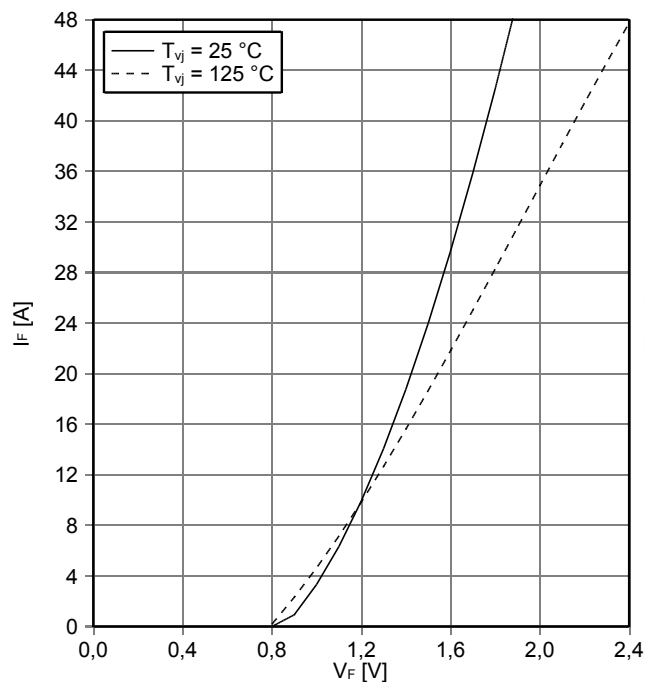
順方向特性 バイパスダイオード ( 典型 )  
forward characteristic of Bypass-Diode (typical)

$I_F = f(V_F)$

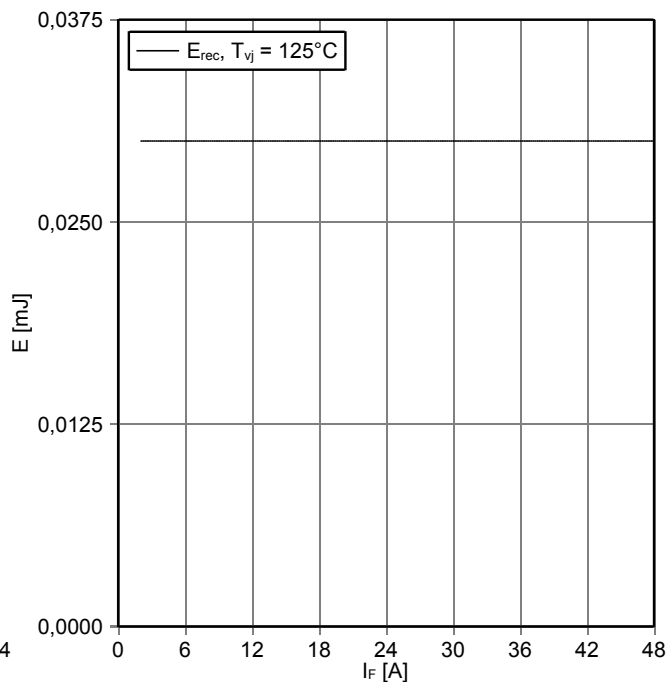


暫定データ  
Preliminary Data

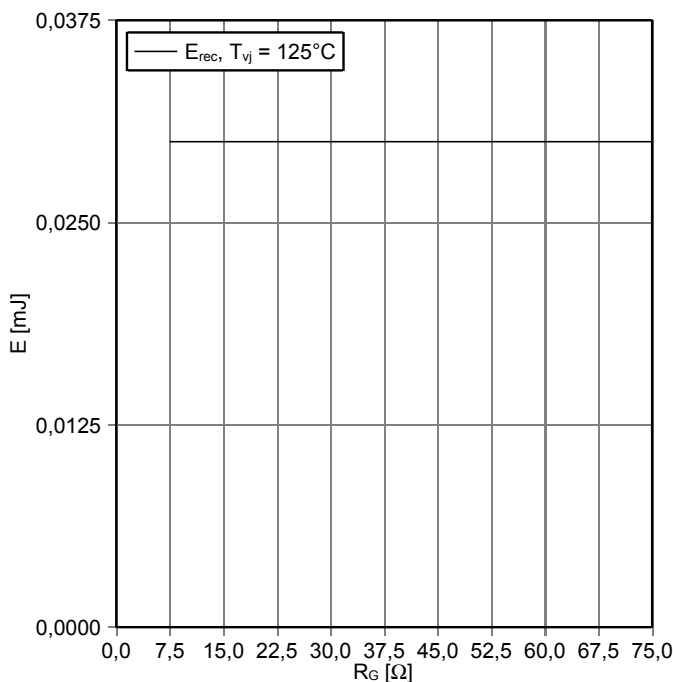
順電圧特性 Diode, アップコンバータ ( typical)  
forward characteristic of Diode, Boost (typical)  
 $I_F = f(V_F)$



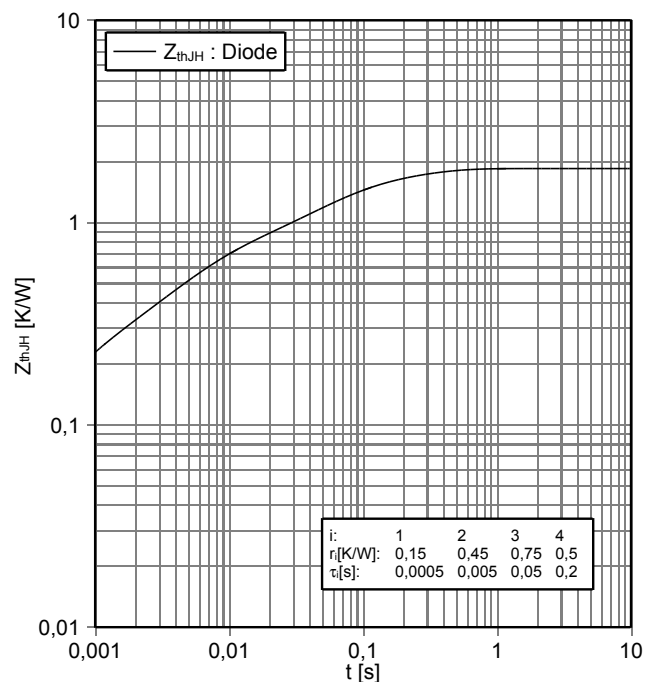
スイッチング損失 Diode, アップコンバータ (Typical)  
switching losses Diode, Boost (typical)  
 $E_{rec} = f(I_F)$   
 $R_{Gon} = 8.2 \Omega$ ,  $V_{CE} = 400 V$



スイッチング損失 Diode, アップコンバータ (Typical)  
switching losses Diode, Boost (typical)  
 $E_{rec} = f(R_G)$   
 $I_F = 24 A$ ,  $V_{CE} = 400 V$

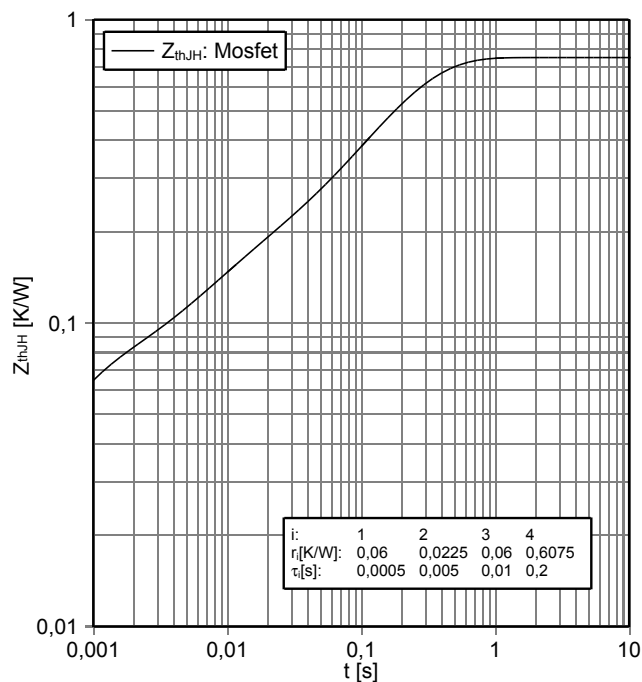


過渡熱インピーダンス Diode, アップコンバータ  
transient thermal impedance Diode, Boost  
 $Z_{thJH} = f(t)$

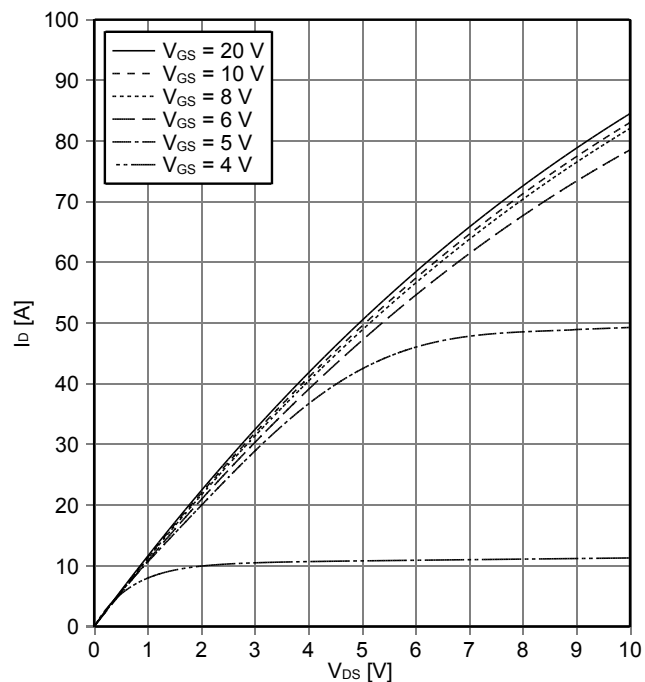


暫定データ  
Preliminary Data

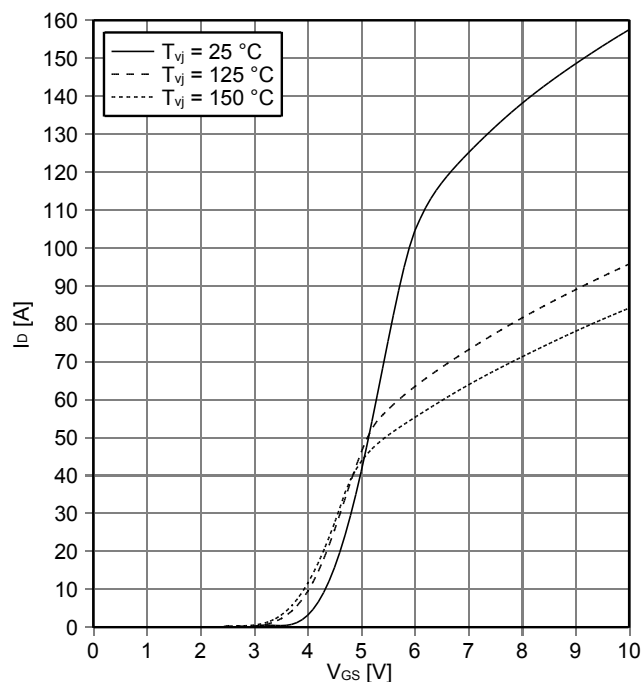
過渡熱インピーダンス MOSFET  
transient thermal impedance MOSFET  
 $Z_{thJH} = f(t)$



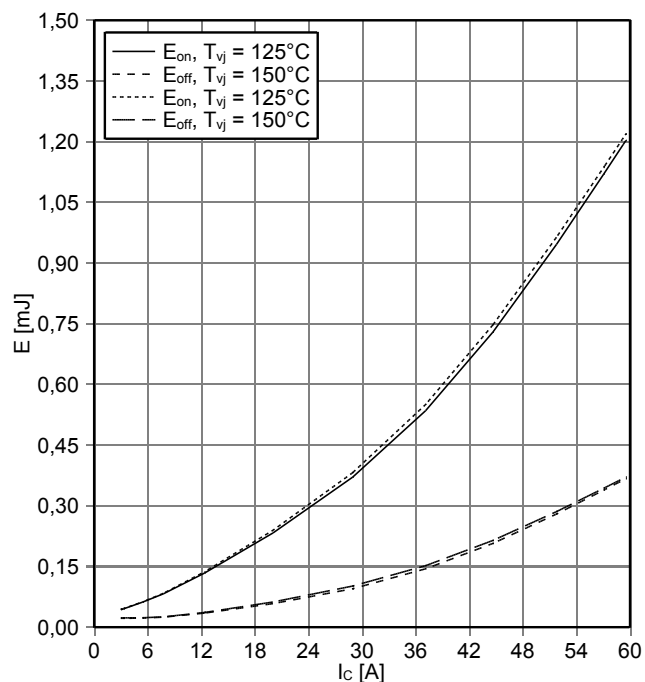
出力特性 MOSFET (Typical)  
output characteristic MOSFET (typical)  
 $I_D = f(V_{DS})$   
 $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$



伝達特性 MOSFET (Typical)  
transfer characteristic MOSFET (typical)  
 $I_D = f(V_{GS})$   
 $V_{DS} = 10\text{ V}$



スイッチング損失 MOSFET (Typical)  
switching losses MOSFET (typical)  
 $E_{on} = f(I_C)$ ,  $E_{off} = f(I_C)$   
 $V_{GS} = \pm 15\text{ V}$ ,  $R_{Gon} = 7,5\ \Omega$ ,  $R_{Goff} = 7,5\ \Omega$ ,  $V_{DS} = 400\text{ V}$

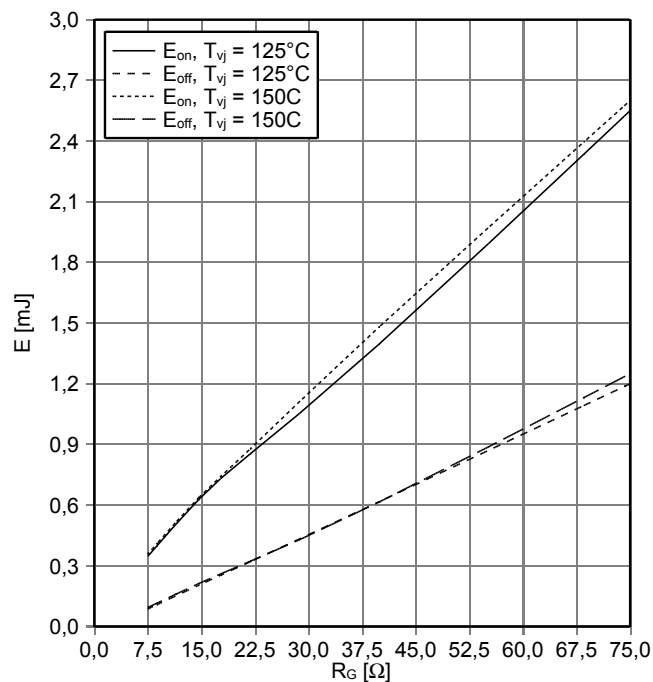


暫定データ  
Preliminary Data

スイッチング損失 MOSFET (Typical)  
switching losses MOSFET (typical)

$E_{on} = f(R_G)$ ,  $E_{off} = f(R_G)$

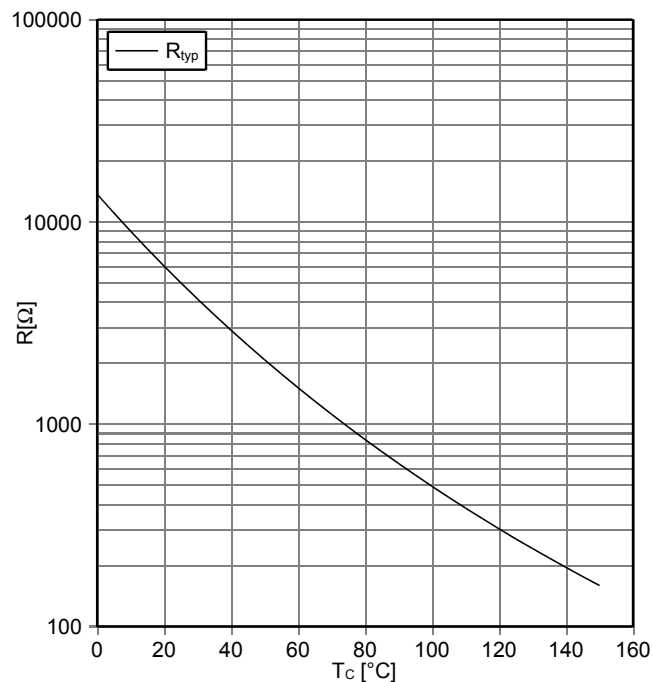
$V_{GS} = \pm 15\text{ V}$ ,  $I_D = 37.5\text{ A}$ ,  $V_{DS} = 400\text{ V}$



NTC-サーミスタ サーミスタの温度特性

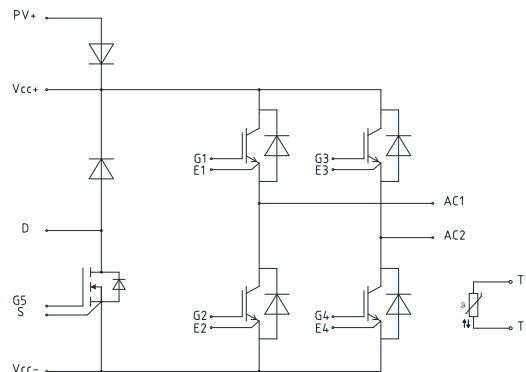
NTC-Thermistor-temperature characteristic (typical)

$R = f(T)$

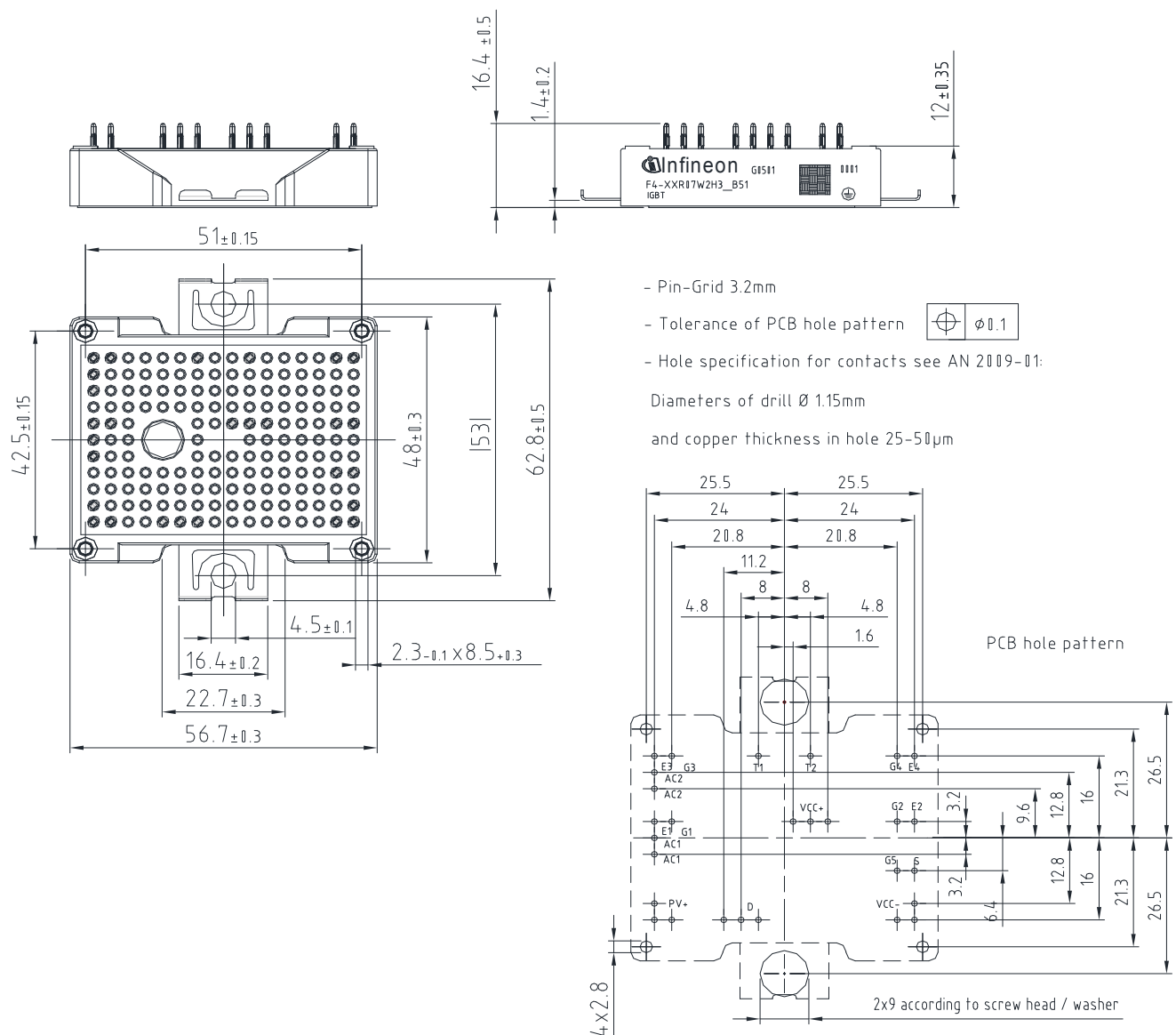


暫定データ  
Preliminary Data

回路図 / circuit\_diagram\_headline



パッケージ概要 / package outlines



prepared by: MB  
approved by: AKDA

date of publication: 2014-10-15  
revision: 2.0

**暫定データ  
Preliminary Data**

この日本語は、あくまで参考訳となりますので、正式はデータシートに記載されている英文の物となります。

この日本語は、あくまで参考訳となりますので、正式はデータシートに記載されている英文の物となります。

**利用規約**

このデータシートに記載されているデータ類は、技術者向けの物です。このデバイスを使用される際は、製品が使用されるアプリケーションにて、ご評価頂いた上で、アプリケーションに適切かご判断願います。

このデータシートには、保証されている特性が記述されております。

その他、保証内容は個々の契約期間や条件に応じて決定されます。

保証は、アプリケーションやその特性に対しては行いません。

実際のアプリケーションでの利用に関しては、必ず相当モジュールのアセンブリノートをご確認ください。

追加の技術的情報、アプリケーションでの使用方法について、ご質問がある際には、最寄のセールスオフィスにお問い合わせ願います。(www.infineon.com 参照)

製品にご興味頂き必要があれば、アプリケーションノートを準備させて頂くケースもあります。

技術的な要求によっては、当該製品が危険な物になり得る可能性があります。このようなことが起こる可能性がある場合は、製品を使用される方の責任にて、弊社セールスオフィスに連絡願います。

航空関連、もしくは医療機器や生命維持装置に使用される場合は、インフィニオンと下記の項目を合意しているか、ご確認願います。

- リスク 及び 品質の評価
- 品質契約
- アプリケーションの共同評価

上記の内容の状況に応じて、製品を出荷の判断をさせて頂く場合がございます。

必要に応じて、この規約を関係される方々に送付してください。

インフィニオンはこのデータシートを変更する権利を有します。

**Terms & Conditions of usage**

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its characteristics. The information in the valid application- and assembly notes of the module must be considered.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you ( see www.infineon.com ). For those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend

- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.

prepared by: MB	date of publication: 2014-10-15
approved by: AKDA	revision: 2.0